

SOT23 N-CANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ZVN3320F

ISSUE 3 – DECEMBER 1995 ☆

FEATURES

- * 200 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)} = 25\Omega$

PARTMARKING DETAIL – MU

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	200	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	I_D	60	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	1	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	330	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j:T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	200		V	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{GS} = 0\text{V}$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	1.0	3.0	V	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{DS} = V_{GS}$
Gate-Body Leakage	I_{GSS}		100	nA	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}		10 50	μA μA	$V_{DS} = 200\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 160\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $T = 125^{\circ}\text{C}(2)$
On-State Drain Current(1)	$I_{D(on)}$	250		mA	$V_{DS} = 25\text{V}$, $V_{GS} = 10\text{V}$
Static Drain-Source On-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$		25	Ω	$V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 100\text{mA}$
Forward Transconductance(1)(2)	g_{fs}	75		mS	$V_{DS} = 25\text{V}$, $I_D = 100\text{mA}$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		45	pF	$V_{DS} = 25\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Common Source Output Capacitance (2)	C_{oss}		18	pF	
Reverse Transfer Capacitance (2)	C_{rss}		5	pF	
Turn-On Delay Time (2)(3)	$t_{d(on)}$		5	ns	$V_{DD} \approx 25\text{V}$, $I_D = 100\text{mA}$
Rise Time (2)(3)	t_r		7	ns	
Turn-Off Delay Time (2)(3)	$t_{d(off)}$		6	ns	
Fall Time (2)(3)	t_f		6	ns	

(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

(3) Switching times measured with 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9